

## 製品概要

### FJN3305R: NPNエピタキシャルシリコントランジスター、バイアス抵抗内蔵

技術情報は、データシートをご参照ください。

抵抗内蔵トランジスターは、部品数を減らし回路設計を簡素化することで、優れた省スペース、省コストソリューションを実現します。

### 特長

- 100 mA 出力電流能力
- 内蔵バイアス抵抗 (R1=4.7K。R2=10KΩ )

### アプリケーション

- This product is general usage and suitable for many different applications.

### 電氣的仕様

製品	Compliance	Status	Polarity	I <sub>C</sub> Continuous (A)	V <sub>(BR)CEO</sub> Min (V)	h <sub>FE</sub> Min	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	R1/R2 Typ	V <sub>i(off)</sub> Max (V)	V <sub>i(on)</sub> Min (V)	Package Type
FJN3305RTA	Pb-free	Active	NPN	0.1	50	30	4.7	10	0.47	0.3	2.5	TO-92-3 LF

詳細は、弊社 [www.onsemi.jp](http://www.onsemi.jp) の営業または販売代理店にお問い合わせください。

8/18/2019 作成